

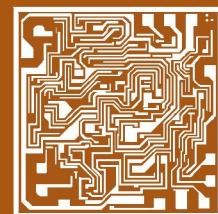
ISSN 0544-1269

Том 54, Номер 2

Март–Апрель 2025



# МИКРОЭЛЕКТРОНИКА / RUSSIAN MICROELECTRONICS



# **СОДЕРЖАНИЕ**

---

---

**Том 54, номер 2, 2025**

---

## **ДИАГНОСТИКА**

Закономерности переноса рентгеновского излучения в легированных многокомпонентных полупроводниках для дозиметрии

*С. М. Асадов, С. Н. Мустафаева, В. Ф. Лукичев*

93

Измерение энергии адгезии между элементами МЭМС с помощью залипшего кантителевера

*И. В. Уваров, О. В. Морозов, А. В. Постников, В. Б. Световой*

116

---

## **МЕМРИСТОРЫ**

Многоуровневые переключения в мемристивных структурах на основе оксицированного селенида свинца

*Н. А. Тулина, А. Н. Россоленко, И. М. Шмытько, И. Ю. Борисенко, Д. Н. Борисенко,  
Н. Н. Колесников*

128

---

## **НАНОСТРУКТУРЫ**

Электрические характеристики рутениевых дорожек с площадью поперечного сечения менее  $1000 \text{ нм}^2$

*О. Г. Глаз, А. Е. Рогожин*

139

---

## **НАНОТРАНЗИСТОРЫ**

Влияние шероховатости границы на вариативность ВАХ кремневых полевых ГАА нанотранзисторов

*Н. В. Масальский*

152

---

## **ПРИБОРЫ**

Сегнетоэлектрические транзисторы: принципы работы, материалы, приложения

*А. Ю. Резнюков, К. А. Фетисенкова, А. Е. Рогожин*

164

---

## **ТЕХНОЛОГИИ**

Прецизионное травление алюминиевых проводников в технологии коммутирующих устройств микросистемной техники

*П. И. Дидақ, А. А. Жуков*

182

---

# CONTENTS

---

---

Volume 54, No 2, 2025

---

## DIAGNOSTICS

Regularities of X-ray transfer in doped multicomponent semiconductors for dosimetry

*S. M. Asadov, S. N. Mustafaeva, V. F. Lukichev*

93

Measuring adhesion energy between MEMS structures using an adhered cantilever

*I. V. Uvarov, O. V. Morozov, A. V. Postnikov, V. B. Svetovoy*

116

---

## MEMRISTORS

Multilevel switchings in memristive structures based on oxidized lead selenide

*N. A. Tulina, A. N. Rossolenko, I. M. Shmytko, I. Yu. Borisenko, D. N. Borisenko, N. N. Kolesnikov*

128

---

## NANOSTRUCTURES

Electrical characteristics of ruthenium lines with a cross-sectional area less than 1000 nm<sup>2</sup>

*O. G. Glaz, A. E. Rogozhin*

139

---

## NANOTRANSISTORS

Effect of boundary roughness on the variability of the I-V data of silicon field-effect GAA nanotransistors

*N. V. Masalsky*

152

---

## APPLICATIONS

Ferroelectric transistors: operating principles, materials, applications

*A. Yu. Reznyukov, K. A. Fetisenkova, A. E. Rogozhin*

164

---

## TECHNOLOGIES

Precision etching of aluminum conductors in the technology of switching devices of microsystems technology

*P. I. Didyk, A. A. Zhukov*

182

---